

Председателю диссертационного  
совета Д 002. 034. 01  
на базе ИАП РАН  
д.т.н., проф. Курочкину В.Е.

## ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый Владимир Ефимович!

Настоящим подтверждаю свое согласие выступить в качестве официального оппонента по диссертации Лысака Владимира Валерьевича «Разработка элементов сверхкоротких оптических соединений с учетом динамических процессов и транспорта носителей в микрорезонаторах и наноструктурах» по специальностям 01.04.01 – «Приборы и методы экспериментальной физики», 01.04.10 – «Физика полупроводников», представленной на соискание ученой степени доктора физико-математических наук.

О себе сообщаю:

Фамилия Имя Отчество оппонента	Гайслер Владимир Анатольевич
Шифр и наименование специальностей, по которым защищена диссертация	01.04.10 - физика полупроводников
Ученая степень и отрасль науки	Доктор физико-математических наук
Ученое звание	Старший научный сотрудник
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук
Занимаемая должность, с указанием структурного подразделения	Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярно-лучевой эпитаксии полупроводниковых соединений АЗ-В5
Почтовый индекс, адрес	630090, Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 13
Телефон	8-9607857500
Адрес электронной почты	haisler@isp.nsc.ru
Список основных публикаций официального оппонента по теме	1) A. Strittmatter, A. Schliwa, J.-H. Schulze, T. D. Germann, A. Dreismann, O. Hitzemann, E. Stock, I. A.

диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)

Ostapenko, S. Rodt, W. Unrau, U. W. Pohl, A. Hoffmann, D. Bimberg and V. Haisler, Lateral positioning of InGaAs quantum dots using a buried stressor, Appl. Phys. Lett. 100, 093111 (2012)

2) A.Strittmatter, A.Holzbecher, A.Schliwa, J.-H.Schulze, D.Quandt, T. D. Germann, A. Dreismann, O. Hitzemann, E. Stock, I.Ostapenko, S. Rodt, W. Unrau, U. Pohl, A.Hoffmann, D. Bimberg and V. Haisler, Site-controlled quantum dot growth on buried oxide stressor layers, Phys. Status Solidi A, Vol 209, Issue 12, pages 2411-2420, Dec 2012

3) А. В. Гайслер, А. С. Ярошевич, И. А. Дербезов, А. К. Калагин, А. К. Бакаров, А. И. Торопов, Д. В. Щеглов, В. А. Гайслер, А. В. Латышев, А. Л. Асеев, Тонкая структура экситонных состояний InAs квантовых точек, Письма в ЖЭТФ, том 97, вып. 5, с. 313 – 318, 2013 г. 10 марта

4) А. В. Гайслер, А. С. Ярошевич, И. А. Дербезов, А. К. Калагин, А. К. Бакаров, А. И. Торопов, Д. В. Щеглов, В. А. Гайслер, А. В. Латышев, А. Л. Асеев, «Спектроскопия одиночных InAs квантовых точек», Автометрия, т.49, №5, стр. 93 – 99, (2013)

5) В. А. Гайслер, А. В. Гайслер, А. С. Ярошевич, И. А. Дербезов, М. М. Качанова, Ю. А. Живодков, Т. А. Гаврилова, А. С. Медведев, Л. А. Ненашева, К. В. Грачев, В. К. Сандырев, А. С. Кожухов, В. М. Шаяхметов, А. К. Калагин, А. К. Бакаров, Д. В. Дмитриев, А. И. Торопов, Д. В. Щеглов, А. В. Латышев, А. Л. Асеев «Эффективные излучатели одиночных фотонов на основе селективно позиционированных InAs квантовых точек и брэгговских микрорезонаторов», Физика и техника полупроводников, т.49, вып.1, стр. 35 - 40, 2015

6) В.А. Гайслер, И.А. Дербезов, А.В. Гайслер, А.К. Бакаров, А.И. Торопов, Д.В. Щеглов, А.В. Латышев, А.Л. Асеев «Неклассические излучатели на основе квантовых точек», Вестник РФФИ, вып. 4, стр. 42-54, 2015

7) В.Т. Шамирзаев, В.А. Гайслер, Т.С. Шамирзаев, Краевая и дефектная люминесценция мощных InGaN/GaN ультрафиолетовых светоизлучающих диодов, Физика и техника полупроводников, 2016,

	<p>т.50, вып.11, с.1513-1518.</p> <p>8) В.Т. Шамирзаев, В.А. Гайслер, Т.С. Шамирзаев, Отрицательное дифференциальное сопротивление в мощных InGaN/GaN лазерных диодах, Автометрия, 2016, т.52, №5, с.31-36.</p>
--	---

Гайслер В.А.



---

Подпись и фамилию сотрудника ИФП СО РАН  
В. А. Гайслера удостоверяю

Ученый Секретарь ИФП СО РАН  
к.ф.-м.н

Аржанникова С.А.

« 12 » января 2017 г.

